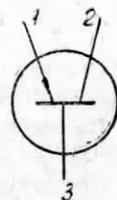
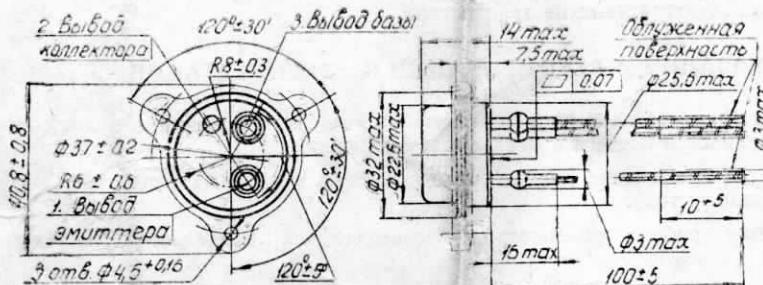




ТРАНЗИСТОРЫ ГЕРМАНИЕВЫЕ ТИПОВ: П210Б, П210В.

ГОСТ 5.1901-73



В одном транзисторе содержится 29,8 мг серебра. Вес с фланцем ≤ 45 г.

I. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ (при $I_{окр.ср.} = +25 \pm 10^\circ\text{C}$)

Тип транзистора	Обратный ток коллектора, мА	Напряжение лавинного пробоя при $I_{к.ампл.} = 2,5\text{а}$	Статический коэффициент передачи тока при $U_{кэ} = -2\text{в}$ $I_k = 5\text{а}$	Статическая крутизна на прямой передаче от входа на выход транзистора при: $U_{кэ} = -2\text{в}; I_k = 5\text{а}$ а/в
П210Б	≤ 15 при $U_{кб} = -45\text{в}$	≥ 40	≥ 10	≥ 5
П210В	≤ 15 при $U_{кб} = -35\text{в}$	≥ 40	≥ 10	≥ 5

II. ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Наименование параметров	Типы транзисторов		Примечание
	П210Б	П210В	
Ток коллектора I_k , в а	12	12	1
Максимально допустимое напряжение между коллектором и базой $U_{кб}$ max, в В	65	45	1
Максимально допустимое напряжение между коллектором и эмиттером $U_{кэ}$ max, в В	50	40	1
Максимально допустимое напряжение между эмиттером и базой $U_{эб}$ max., в В	25	25	1
Мощность, рассеиваемая транзистором P_{max} в вт	45	45	2
Максимальная температура перехода T_p max, в $^\circ\text{C}$.	70	70	
Тепловое сопротивление транзистора R_t в $^\circ\text{C}/\text{вт}$	1	1	

Примечания: 1. В интервале температур окружающей среды от -60°C до $+60^\circ\text{C}$ при условии, что температура перехода не превышает $+70^\circ\text{C}$ и мощность при этом не превышает предельную $T_p = T_{корп.} + P_{рас(вт)} \cdot 1^\circ\text{C}/\text{вт}$.

2. При температуре корпуса выше +25°C предельную величину мощности рассчитывают по формуле:

$$P_{\max} = \frac{(70 - T_{\text{корп.}})^\circ\text{C}}{1^\circ\text{C}/\text{вт}} \quad (\text{вт});$$

где: $T_{\text{корп.}}$ — температура корпуса транзистора;
 $1^\circ\text{C}/\text{вт}$ — тепловое сопротивление транзистора.

III. УКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

При включении транзистора в цепь с электрическим напряжением базовый вывод должен присоединяться первым и отключаться последним.

Не рекомендуется применение транзисторов в схемах, в которых цепь базы разомкнута по постоянному току.

Не рекомендуется работа транзисторов в совмещенных предельно-допускаемых режимах.

Допускается использование транзисторов при температуре +70°C, при этом отклонение электрических параметров от норм ГОСТом 14875—69 не устанавливается.

При монтаже транзистор плотно привинчивают с помощью крепежного фланца к теплоотводящей панели с отшлифованной поверхностью.

Пайку следует производить паяльником мощностью 50÷60 вт не более 10 сек., при этом температура пайки не должна превышать $+285 \pm 5^\circ\text{C}$.

Если по условиям эксплуатации предъявляются дополнительные требования к транзисторам, то вопрос о применении их решается в порядке, установленном руководящим техническим материалом «Порядок согласования применения и режимов использования полупроводниковых приборов».

IV. ГАРАНТИЙНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Гарантии изготовителя по ГОСТ 11630—70 и ГОСТ 5.1901—73.

V. ОТК ПРОСИТ

по окончании эксплуатации транзисторов возвратить заполненный паспорт предприятию-изготовителю.



Дата включения:

Дата выключения:

Число фактических часов работы:

Основные данные режима эксплуатации

Причины выхода из строя:

Адрес потребителя:

Начальник ОТК: